

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFS5C604NLWFT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.9W (Ta), 200W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Ta), 287A (Tc)

Sie können auch interessiert

Verwandtes Hot-Keyword				Mehr
NVMFS5C604NLWFT1G AMI	NVMFS5C604NLWFT1G Datenblatt	NVMFS5C604NLWFT1G-Datenblätter	NVMFS5C604NLWFT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NVMFS5C604NLWFT1G Semiconductor	NVMFS5C604NLWFT1G Electronic	NVMFS5C604NLWFT1G-Komponenten	NVMFS5C604NLWFT1G-Verteiler	NVMFS5C604NLWFT1G-Bild
NVMFS5C604NLWFT1G Preis	NVMFS5C604NLWFT1G Hersteller	NVMFS5C604NLWFT1G Bild	NVMFS5C604NLWFT1G Aktie	NVMFS5C604NLWFT1G-Teil
NVMFS5C604NLWFT1G Neu	NVMFS5C604NLWFT1G Original	NVMFS5C604NLWFT1G garantiert	NVMFS5C604NLWFT1G RFQ	NVMFS5C604NLWFT1G Inventar
				NVMFS5C604NLWFT1G Online bestellen